

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 7月17日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-208300

[ST.10/C]:

[JP2002-208300]

出 願 人

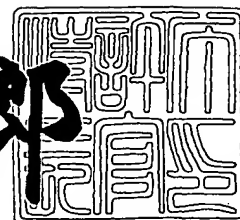
Applicant(s):

大日本スクリーン製造株式会社

2003年 4月25日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3030561

【書類名】 特許願

【整理番号】 P15-1615

【提出日】 平成14年 7月17日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 21/26

【発明者】

 【住所又は居所】 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の
 1 大日本スクリーン製造株式会社内

 【氏名】 楠田 達文

【特許出願人】

 【識別番号】 000207551

 【氏名又は名称】 大日本スクリーン製造株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100089233

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 吉田 茂明

【選任した代理人】

 【識別番号】 100088672

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 吉竹 英俊

【選任した代理人】

 【識別番号】 100088845

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 有田 貴弘

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 012852

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9005666

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 熱処理装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板に対して閃光を照射することによって該基板を加熱する熱処理装置であって、

フラッシュランプを有する光源と、

基板を保持する保持手段と、

前記光源から前記保持手段に保持された基板に向けて光を出射するときに、前記フラッシュランプから出射される光の強度を計測する光強度計測手段と、

前記光強度計測手段による計測結果に基づいて、前記フラッシュランプの発光状態を検出する発光状態検出手段と、

を備えることを特徴とする熱処理装置。

【請求項 2】 請求項 1 記載の熱処理装置において、

前記保持手段に保持された基板への照射状態が所定の基準を満足するときの前記フラッシュランプから出射される光の強度を標準発光強度とし、

前記発光状態検出手段は、前記光強度計測手段による計測結果と前記標準発光強度とを比較して前記フラッシュランプの発光状態を検出することを特徴とする熱処理装置。

【請求項 3】 請求項 1 または請求項 2 に記載の熱処理装置において、

前記フラッシュランプは長尺の円筒形状を有する棒状ランプであり、

前記光強度計測手段は、前記フラッシュランプの両端部を含む複数箇所から出射される光の強度を計測することを特徴とする熱処理装置。

【請求項 4】 請求項 1 から請求項 3 のいずれかに記載の熱処理装置において、

前記光源は、複数のフラッシュランプを有し、

前記光強度計測手段は、前記複数のフラッシュランプのそれぞれから出射される光の強度を計測し、

前記発光状態検出手段は、前記複数のフラッシュランプのそれぞれの発光状態を検出することを特徴とする熱処理装置。

【請求項 5】 請求項 4 記載の熱処理装置において、

前記発光状態検出手段によって検出された前記複数のフラッシュランプのそれぞれの発光状態のうち少なくとも一部に所定の基準を満足しないものが生じたときに所定の異常対応処理を行う異常対応手段をさらに備えることを特徴とする熱処理装置。

【請求項 6】 請求項 4 または請求項 5 に記載の熱処理装置において、

前記発光状態検出手段は、処理対象となる基板に光照射を行うごとに、前記複数のフラッシュランプのそれぞれの発光状態を検出することを特徴とする熱処理装置。

【請求項 7】 請求項 4 から請求項 6 のいずれかに記載の熱処理装置において、

前記光強度計測手段は、前記複数のフラッシュランプのそれぞれから出射される光を導く複数の光ファイバーと、前記複数の光ファイバーによって導かれた光を受光する単一の受光素子とを含むことを特徴とする熱処理装置。

【請求項 8】 基板に対して光を照射することによって該基板を加熱する熱処理装置であって、

複数のランプを有する光源と、

基板を保持する保持手段と、

前記複数のランプのそれぞれにおける複数箇所から出射される光の強度を計測する光強度計測手段と、

前記光強度計測手段による計測結果に基づいて、前記複数のランプのそれぞれの発光状態を検出する発光状態検出手段と、
を備えることを特徴とする熱処理装置。

【請求項 9】 請求項 8 記載の熱処理装置において、

前記保持手段に保持された基板への照射状態が所定の基準を満足するときの前記複数のランプのそれぞれから出射される光の強度を標準発光強度とし、

前記発光状態検出手段は、前記光強度計測手段による計測結果と前記標準発光強度とを比較して前記複数のランプのそれぞれの発光状態を検出することを特徴とする熱処理装置。

【請求項10】 請求項8または請求項9に記載の熱処理装置において、
前記発光状態検出手段によって検出された前記複数のランプのそれぞれの発光状態のうち少なくとも一部に所定の基準を満足しないものが生じたときに所定の異常対応処理を行う異常対応手段をさらに備えることを特徴とする熱処理装置。

【請求項11】 請求項8から請求項10のいずれかに記載の熱処理装置において、

前記光強度計測手段は、前記複数のランプのそれぞれから出射される光を導く複数の光ファイバーと、前記複数の光ファイバーによって導かれた光を受光する単一の受光素子とを含むことを特徴とする熱処理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、半導体ウェハーやガラス基板等（以下、単に「基板」と称する）に光を照射することにより基板を熱処理する熱処理装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来より、イオン注入後の半導体ウェハーのイオン活性化工程においては、ハロゲンランプを使用したランプアニール装置等の熱処理装置が使用されている。このような熱処理装置においては、半導体ウェハーを、例えば、1000℃ないし1100℃程度の温度に加熱（アニール）することにより、半導体ウェハーのイオン活性化を実行している。そして、このような熱処理装置においては、ハロゲンランプより照射される光のエネルギーを利用することにより、毎秒数百度程度の速度で基板を昇温する構成となっている。

【0003】

しかしながら、毎秒数百度程度の速度で基板を昇温する熱処理装置を使用して半導体ウェハーのイオン活性化を実行した場合においても、半導体ウェハーに打ち込まれたイオンのプロファイルがなまる、すなわち、熱によりイオンが拡散してしまうという現象が生ずることが判明した。このような現象が発生した場合においては、半導体ウェハーの表面にイオンを高濃度で注入しても、注入後のイオ

ンが拡散してしまうことから、イオンを必要以上に注入しなければならないという問題が生じていた。

【0004】

上述した問題を解決するため、キセノンフラッシュランプ等を使用して半導体ウェハーの表面に閃光を照射することにより、イオンが注入された半導体ウェハーの表面のみを極めて短時間（数ミリセカンド以下）に昇温させる技術が提案されている。キセノンフラッシュランプによる極短時間の昇温であれば、イオンが拡散するための十分な時間がないため、半導体ウェハーに打ち込まれたイオンのプロファイルをなまらせることなく、イオン活性化のみを実行することができるのである。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

ところが、このようなキセノンフラッシュランプを複数配列したランプユニットの管理を全く行わないと、それらのうちの1本が劣化を起こしたとしてもランプシステムの全体としてそれを検出することができず、劣化したランプ直下の光量が低下したまま半導体ウェハーの処理が続行されることとなる。その結果、面内の一部に処理異常が生じている半導体ウェハーが多量に生産されるという問題が生じることとなる。

【0006】

このため、キセノンフラッシュランプの管理が重要となるのであるが、キセノンフラッシュランプは電荷蓄積したコンデンサのエネルギーを一瞬で放電して閃光を放つものであるため、制御という概念が無く、ランプ管理自体が非常に困難であり、その手法が問題となっていた。

【0007】

キセノンフラッシュランプの管理手法として従来より多く用いられてきたのが処理済のウェハーを定期的にサンプリングして検査する間接管理方法である。具体的には、数ロットに1枚程度の処理済ウェハーを抜き出して表面のシート抵抗を計測することによって適切な熱処理がなされたか否かを検査するのである。しかしながら、この手法では、検査の結果異常が認められたとしても、検査間に処

理された多くの半導体ウェハーにも処理異常が生じている可能性が高く、リスクが大きい。

【 0 0 0 8 】

また、閃光照射時の電流特性を監視することによってフラッシュランプの異常を検出するという手法も提案されている。しかし、フラッシュランプの劣化の要因には、電極のスパッタに起因したガラス管の黒化など種々のものがあり、電流特性を監視してもこのような現象によるフラッシュランプの劣化までは検知することができない。

【 0 0 0 9 】

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、ランプの劣化を確実にかつ簡便に検出することができる熱処理装置を提供することを目的とする。

【 0 0 1 0 】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、請求項 1 の発明は、基板に対して閃光を照射することによって該基板を加熱する熱処理装置において、フラッシュランプを有する光源と、基板を保持する保持手段と、前記光源から前記保持手段に保持された基板に向けて光を出射するときに、前記フラッシュランプから出射される光の強度を計測する光強度計測手段と、前記光強度計測手段による計測結果に基づいて、前記フラッシュランプの発光状態を検出する発光状態検出手段と、を備える。

【 0 0 1 1 】

また、請求項 2 の発明は、請求項 1 の発明にかかる熱処理装置において、前記保持手段に保持された基板への照射状態が所定の基準を満足するときの前記フラッシュランプから出射される光の強度を標準発光強度とし、前記発光状態検出手段に、前記光強度計測手段による計測結果と前記標準発光強度とを比較して前記フラッシュランプの発光状態を検出させている。

【 0 0 1 2 】

また、請求項 3 の発明は、請求項 1 または請求項 2 の発明にかかる熱処理装置において、前記フラッシュランプを長尺の円筒形状を有する棒状ランプとし、前記光強度計測手段に、前記フラッシュランプの両端部を含む複数箇所から出射さ

れる光の強度を計測させている。

【 0 0 1 3 】

また、請求項 4 の発明は、請求項 1 から請求項 3 のいずれかの発明にかかる熱処理装置において、前記光源に複数のフラッシュランプを有させ、前記光強度計測手段に、前記複数のフラッシュランプのそれぞれから出射される光の強度を計測させ、前記発光状態検出手段に、前記複数のフラッシュランプのそれぞれの発光状態を検出させている。

【 0 0 1 4 】

また、請求項 5 の発明は、請求項 4 の発明にかかる熱処理装置において、前記発光状態検出手段によって検出された前記複数のフラッシュランプのそれぞれの発光状態のうち少なくとも一部に所定の基準を満足しないものが生じたときに所定の異常対応処理を行う異常対応手段をさらに備える。

【 0 0 1 5 】

また、請求項 6 の発明は、請求項 4 または請求項 5 の発明にかかる熱処理装置において、前記発光状態検出手段に、処理対象となる基板に光照射を行うごとに、前記複数のフラッシュランプのそれぞれの発光状態を検出させている。

【 0 0 1 6 】

また、請求項 7 の発明は、請求項 4 から請求項 6 のいずれかの発明にかかる熱処理装置において、前記光強度計測手段に、前記複数のフラッシュランプのそれぞれから出射される光を導く複数の光ファイバーと、前記複数の光ファイバーによって導かれた光を受光する単一の受光素子とを含ませている。

【 0 0 1 7 】

また、請求項 8 の発明は、基板に対して光を照射することによって該基板を加熱する熱処理装置において、複数のランプを有する光源と、基板を保持する保持手段と、前記複数のランプのそれぞれにおける複数箇所から出射される光の強度を計測する光強度計測手段と、前記光強度計測手段による計測結果に基づいて、前記複数のランプのそれぞれの発光状態を検出する発光状態検出手段と、を備える。

【 0 0 1 8 】

また、請求項 9 の発明は、請求項 8 の発明にかかる熱処理装置において、前記保持手段に保持された基板への照射状態が所定の基準を満足するときの前記複数のランプのそれぞれから出射される光の強度を標準発光強度とし、前記発光状態検出手段に、前記光強度計測手段による計測結果と前記標準発光強度とを比較して前記複数のランプのそれぞれの発光状態を検出させている。

【 0 0 1 9 】

また、請求項 1 0 の発明は、請求項 8 または請求項 9 の発明にかかる熱処理装置において、前記発光状態検出手段によって検出された前記複数のランプのそれぞれの発光状態のうち少なくとも一部に所定の基準を満足しないものが生じたときに所定の異常対応処理を行う異常対応手段をさらに備える。

【 0 0 2 0 】

また、請求項 1 1 の発明は、請求項 8 から請求項 1 0 のいずれかの発明にかかる熱処理装置において、前記光強度計測手段に、前記複数のランプのそれぞれから出射される光を導く複数の光ファイバーと、前記複数の光ファイバーによって導かれた光を受光する単一の受光素子とを含ませている。

【 0 0 2 1 】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について詳細に説明する。

【 0 0 2 2 】

図 1 および図 2 は本発明にかかる熱処理装置の構成を示す側断面図である。この熱処理装置は、キセノンフラッシュランプからの閃光によって半導体ウェハー等の基板の熱処理を行う装置である。

【 0 0 2 3 】

この熱処理装置は、透光板 6 1、底板 6 2 および一对の側板 6 3、6 4 からなり、その内部に半導体ウェハー W を収納して熱処理するためのチャンバー 6 5 を備える。チャンバー 6 5 の上部を構成する透光板 6 1 は、例えば、石英等の赤外線透過性を有する材料から構成されており、光源 5 から出射された光を透過してチャンバー 6 5 内に導くチャンバー窓として機能している。また、チャンバー 6 5 を構成する底板 6 2 には、後述する熱拡散板 7 3 および加熱プレート 7 4 を貫

通して半導体ウェハーWをその下面から支持するための支持ピン70が立設されている。

【0024】

また、チャンバー65を構成する側板64には、半導体ウェハーWの搬入および搬出を行うための開口部66が形成されている。開口部66は、軸67を中心に回転するゲートバルブ68により開閉可能となっている。半導体ウェハーWは、開口部66が解放された状態で、図示しない搬送ロボットによりチャンバー65内に搬入される。また、チャンバー65内にて半導体ウェハーWの熱処理が行われるときには、ゲートバルブ68により開口部66が閉鎖される。

【0025】

チャンバー65は光源5の下方に設けられている。光源5は、複数（本実施形態においては27本）のキセノンフラッシュランプ69（以下、単に「フラッシュランプ69」とも称する）と、リフレクタ71とを備える。複数のフラッシュランプ69は、それぞれが長尺の円筒形状を有する棒状ランプであり、それぞれの長手方向が水平方向に沿うようにして互いに平行に列設されている。リフレクタ71は、複数のフラッシュランプ69の上方にそれらの全体を被うように配設されている。

【0026】

このキセノンフラッシュランプ69は、その内部にキセノンガスが封入されその両端部にコンデンサーに接続された陽極および陰極が配設されたガラス管と、該ガラス管の外局部に巻回されたトリガー電極とを備える。キセノンガスは電気的には絶縁体であることから、通常の状態ではガラス管内に電気は流れない。しかしながら、トリガー電極に高電圧を印加して絶縁を破壊した場合には、コンデンサーに蓄えられた電気がガラス管内に瞬時に流れ、そのときのジュール熱でキセノンガスが加熱されて光が放出される。このキセノンフラッシュランプ69においては、予め蓄えられていた静電エネルギーが0.1ミリセカンドないし10ミリセカンドという極めて短い光パルスに変換されることから、連続点灯の光源に比べて極めて強い光を照射し得るという特徴を有する。本実施形態では、熱処理装置にフラッシュランプ69から出射される光の強度を計測する機構（図1お

よび図2では図示の便宜上省略)を設けているのであるがそれについてはさらに後述する。

【0027】

光源5と透光板61との間には、光拡散板72が配設されている。この光拡散板72は、赤外線透過材料としての石英ガラスの表面に光拡散加工を施したものが使用される。

【0028】

フラッシュランプ69から放射された光の一部は直接に光拡散板72および透光板61を透過してチャンバー65内へと向かう。また、フラッシュランプ69から放射された光の他の一部は一旦リフレクタ71によって反射されてから光拡散板72および透光板61を透過してチャンバー65内へと向かう。

【0029】

チャンバー65内には、加熱プレート74と熱拡散板73とが設けられている。熱拡散板73は加熱プレート74の上面に貼着されている。また、熱拡散板73の表面には、半導体ウェハWの位置ずれ防止ピン75が付設されている。

【0030】

加熱プレート74は、半導体ウェハWを予備加熱(アシスト加熱)するためのものである。この加熱プレート74は、窒化アルミニウムにて構成され、その内部にヒータと該ヒータを制御するためのセンサとを収納した構成を有する。一方、熱拡散板73は、加熱プレート74からの熱エネルギーを拡散して半導体ウェハWを均一に予備加熱するためのものである。この熱拡散板73の材質としては、サファイア(Al_2O_3 : 酸化アルミニウム)や石英等の比較的熱伝導率が小さいものが採用される。

【0031】

熱拡散板73および加熱プレート74は、モータ40の駆動により、図1に示す半導体ウェハWの搬入・搬出位置と図2に示す半導体ウェハWの熱処理位置との間を昇降する構成となっている。

【0032】

すなわち、加熱プレート74は、筒状体41を介して移動板42に連結されて

いる。この移動板42は、チャンバー65の底板62に釣支されたガイド部材43により案内されて昇降可能となっている。また、ガイド部材43の下端部には、固定板44が固定されており、この固定板44の中央部にはボールネジ45を回転駆動するモータ40が配設されている。そして、このボールネジ45は、移動板42と連結部材46、47を介して連結されたナット48と螺合している。このため、熱拡散板73および加熱プレート74は、モータ40の駆動により、図1に示す半導体ウェハ－Wの搬入・搬出位置と図2に示す半導体ウェハ－Wの熱処理位置との間を昇降することができる。

【0033】

図1に示す半導体ウェハ－Wの搬入・搬出位置は、図示しない搬送ロボットを使用して開口部66から搬入した半導体ウェハ－Wを支持ピン70上に載置し、あるいは、支持ピン70上に載置された半導体ウェハ－Wを開口部66から搬出することができるように、熱拡散板73および加熱プレート74が下降した位置である。この状態においては、支持ピン70の上端は、熱拡散板73および加熱プレート74に形成された貫通孔を通過し、熱拡散板73の表面より上方に突出する。

【0034】

一方、図2に示す半導体ウェハ－Wの熱処理位置は、半導体ウェハ－Wに対して熱処理を行うために、熱拡散板73および加熱プレート74が支持ピン70の上端より上方に上昇した位置である。熱拡散板73および加熱プレート74が図1の搬入・搬出位置から図2の熱処理位置に上昇する過程において、支持ピン70に載置された半導体ウェハ－Wは熱拡散板73によって受け取られ、その下面を熱拡散板73の表面に支持されて上昇し、チャンバー65内の透光板61に近接した位置に水平姿勢にて保持される。逆に、熱拡散板73および加熱プレート74が熱処理位置から搬入・搬出位置に下降する過程においては、熱拡散板73に支持された半導体ウェハ－Wは支持ピン70に受け渡される。

【0035】

半導体ウェハ－Wを支持する熱拡散板73および加熱プレート74が熱処理位置に上昇した状態においては、それらに保持された半導体ウェハ－Wと光源5と

の間に透光板 6 1 が位置することとなる。なお、このときの熱拡散板 7 3 と光源 5 との間の距離についてはモータ 4 0 の回転量を制御することにより任意の値に調整することが可能である。

【 0 0 3 6 】

また、チャンバー 6 5 の底板 6 2 と移動板 4 2 との間には筒状体 4 1 の周囲を取り囲むようにしてチャンバー 6 5 を気密状態に維持するための伸縮自在の蛇腹 7 7 が配設されている。熱拡散板 7 3 および加熱プレート 7 4 が熱処理位置まで上昇したときには蛇腹 7 7 が収縮し、熱拡散板 7 3 および加熱プレート 7 4 が搬入・搬出位置まで下降したときには蛇腹 7 7 が伸長してチャンバー 6 5 内の雰囲気と外部雰囲気とを遮断する。

【 0 0 3 7 】

チャンバー 6 5 における開口部 6 6 と反対側の側板 6 3 には、開閉弁 8 0 に連通接続された導入路 7 8 が形成されている。この導入路 7 8 は、チャンバー 6 5 内に処理に必要なガス、例えば不活性な窒素ガスを導入するためのものである。一方、側板 6 4 における開口部 6 6 には、開閉弁 8 1 に連通接続された排出路 7 9 が形成されている。この排出路 7 9 は、チャンバー 6 5 内の気体を排出するためのものであり、開閉弁 8 1 を介して図示しない排気手段と接続されている。

【 0 0 3 8 】

上述したように、この熱処理装置にはフラッシュランプ 6 9 から出射される光の強度を計測する機構が設けられている。図 3 は、光強度計測機構の概略構成を示す図である。この光強度計測機構は、主としてフラッシュランプ 6 9 から出射された光を導く複数の光ファイバー 2 0 と、受光した光の強度を電気信号として出力する CCD (Charge Coupled Device) 2 5 と、CCD 2 5 から出力された電気信号を解析するコンピュータ 1 0 とにより構成される。

【 0 0 3 9 】

各光ファイバー 2 0 の一端部はリフレクタ 7 1 に固設されている。図 5 はフラッシュランプ 6 9 に対する光ファイバー 2 0 の配設状態を示す図である。また、図 6 はリフレクタ 7 1 への光ファイバー 2 0 の取付態様を示す拡大図である。図 5 に示すように、本実施形態では 1 本のフラッシュランプ 6 9 に対して 3 本の光

ファイバー 20 を配設している。すなわち、フラッシュランプ 69 は長尺の円筒形状を有する棒状ランプであり、光ファイバー 20 の端面が各フラッシュランプ 69 の中央部および両端部のそれぞれに対向するように構成されている。従って、光源 5 に 27 本のフラッシュランプ 69 が設けられているとすると、リフレクタ 71 には計 81 本の光ファイバー 20 が取り付けられることとなる。具体的な取付態様は図 6 に示すように、リフレクタ 71 におけるフラッシュランプ 69 の直上部分に光ファイバー 20 の径よりも若干大きな穴を穿設し、その穴に光ファイバー 20 の一端部を挿通させた状態にて取付治具 21 により光ファイバー 20 を固定する。光ファイバー 20 の材質は石英製であり、フラッシュランプ 69 からの強烈なフラッシュ光に対しても耐性を備えている。

【0040】

図 5 および図 6 に示すようにして複数の、例えば 81 本の光ファイバー 20 をリフレクタ 71 に取り付けることにより、それら光ファイバー 20 の端面が 27 本のフラッシュランプ 69 の中央部および両端部に対向する。そしてこの状態でフラッシュランプ 69 が閃光を出射すると、出射された光は各光ファイバー 20 の端面に入射して該光ファイバー 20 によって導かれることとなる。

【0041】

一方、各光ファイバー 20 の他端部はファイバー固定治具 22 に固設されている。複数の光ファイバー 20 のファイバー固定治具 22 への接続態様（配列）は CCD 25 の形状に応じて任意のものとすれば良い。例えば、81 本の光ファイバー 20 を一列に並べても良いし、矩形状に配列して並べても良い。本実施形態では、フラッシュランプ 69 の中央部、一端部および他端部のそれぞれに対向する光ファイバー 20 を 27 本ずつ 3 列に並べてファイバー固定治具 22 に固設している。なお、フラッシュランプ 69 に対向する一端面から入射して光ファイバー 20 内を導かれた光がその他端面からファイバー固定治具 22 に遮られることなく出射されることは勿論である。

【0042】

ファイバー固定治具 22 にはフィルター 23 が貼設されている。フィルター 23 としては、その目的に応じて種々のものを採用することができる。例えば、光

ファイバー 20 から出射される光が強すぎる場合には ND フィルター、所定のスペクトルに絞りたい場合にはバンドパスフィルターを採用すれば良い。例えば、フラッシュ加熱に大きく寄与する紫外線側のスペクトルに限ってモニタを行いたい場合には、紫外線側スペクトルに絞るバンドパスフィルターを採用する。また、フィルター 23 として蛍光塗料を塗布したフィルター等を採用することができる。さらに、フィルター 23 の代わりに光拡散板を使用するようにしても良い。

【0043】

CCD 25 は、フォトダイオードを平面状に並べたものであり、蓄積された入射光に比例した電気量を取り出す受光素子である。CCD 25 はファイバー固定治具 22 に対向配置されており、81 本の光ファイバー 20 から出射されてフィルター 23 を透過した光を単一の CCD 25 にて受光することができる。なお、CCD 25 に代わる受光素子として CMOS センサ (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 等を採用するようにしても良い。また、フィルター 23 と CCD 25 との間にレンズ結合系を配置するようにしても良い。

【0044】

CCD 制御回路 27 は、CCD 25 に蓄積された電荷の読み出しを制御する回路である。CCD 制御回路 27 によって CCD 25 から読み出された電気信号はコンピュータ 10 に伝達される。コンピュータ 10 は熱処理装置に付設されているものであり、そのハードウェアとしての構成は一般的なコンピュータと同様である。

【0045】

図 4 は、コンピュータ 10 の構成を示すブロック図である。コンピュータ 10 は、各種演算処理を行う CPU 11、基本プログラムを記憶する読み出し専用のメモリである ROM 12、各種情報を記憶する読み書き自在のメモリである RAM 13 および制御用ソフトウェアやデータなどを記憶しておく磁気ディスク 14 をバスライン 19 に接続して構成されている。また、バスライン 19 には A/D コンバータ 15 が接続されている。A/D コンバータ 15 は、CCD 制御回路 27 によって CCD 25 から読み出されたアナログの電気信号をデジタルに変換する回路である。

【 0 0 4 6 】

さらに、バスライン 1 9 には、表示部 1 6 および入力部 1 7 が電氣的に接続されている。表示部 1 6 は、例えば液晶ディスプレイ等を用いて構成されており、処理結果やレシピ内容等の種々の情報を表示する。入力部 1 7 は、例えばキーボードやマウス等を用いて構成されており、コマンドやパラメータ等の入力を受け付ける。装置のオペレータは、表示部 1 6 に表示された内容を確認しつつ入力部 1 7 からコマンドやパラメータ等の入力を行うことができる。なお、表示部 1 6 と入力部 1 7 とを一体化してタッチパネルとして構成するようにしても良い。

【 0 0 4 7 】

以上のような構成により、本実施形態ではフラッシュランプ 6 9 から出射される光を光ファイバー 2 0 によって導き、その光強度を CCD 2 5 により計測し、得られた計測結果をコンピュータ 1 0 により解析することができる。

【 0 0 4 8 】

次に、本発明にかかる熱処理装置による半導体ウェハ W の熱処理動作について説明する。この熱処理装置において処理対象となる半導体ウェハ W は、イオン注入後の半導体ウェハである。

【 0 0 4 9 】

この熱処理装置においては、熱拡散板 7 3 および加熱プレート 7 4 が図 1 に示す半導体ウェハ W の搬入・搬出位置に配置された状態にて、図示しない搬送ロボットにより開口部 6 6 を介して半導体ウェハ W が搬入され、支持ピン 7 0 上に載置される。半導体ウェハ W の搬入が完了すれば、開口部 6 6 がゲートバルブ 6 8 により閉鎖される。しかる後、熱拡散板 7 3 および加熱プレート 7 4 がモータ 4 0 の駆動により図 2 に示す半導体ウェハ W の熱処理位置まで上昇し、半導体ウェハ W を水平姿勢にて保持する。また、開閉弁 8 0 および開閉弁 8 1 を開いてチャンバー 6 5 内に窒素ガスの気流を形成する。

【 0 0 5 0 】

熱拡散板 7 3 および加熱プレート 7 4 は、加熱プレート 7 4 に内蔵されたヒータの作用により予め所定温度に加熱されている。このため、熱拡散板 7 3 および加熱プレート 7 4 が半導体ウェハ W の熱処理位置まで上昇した状態においては、

、半導体ウェハーWが加熱状態にある熱拡散板73と接触することにより予備加熱され、半導体ウェハーWの温度が次第に上昇する。

【0051】

この状態においては、半導体ウェハーWは熱拡散板73により継続して加熱される。そして、半導体ウェハーWの温度上昇時には、図示しない温度センサにより、半導体ウェハーWの表面温度が予備加熱温度T1に到達したか否かを常に監視する。

【0052】

なお、この予備加熱温度T1は、例えば200℃ないし600℃程度の温度である。半導体ウェハーWをこの程度の予備加熱温度T1まで加熱したとしても、半導体ウェハーWに打ち込まれたイオンが拡散してしまうことはない。

【0053】

やがて、半導体ウェハーWの表面温度が予備加熱温度T1に到達すると、フラッシュランプ69を点灯してフラッシュ加熱を行う。このフラッシュ加熱工程におけるフラッシュランプ69の点灯時間は、0.1ミリセカンドないし10ミリセカンド程度の時間である。このように、フラッシュランプ69においては、予め蓄えられていた静電エネルギーがこのように極めて短い光パルスに変換されることから、極めて強い閃光が照射されることになる。

【0054】

このようなフラッシュ加熱により、半導体ウェハーWの表面温度は瞬間的に温度T2に到達する。この温度T2は、1000℃ないし1100℃程度の半導体ウェハーWのイオン活性化処理に必要な温度である。半導体ウェハーWの表面がこのような処理温度T2にまで昇温されることにより、半導体ウェハーW中に打ち込まれたイオンが活性化される。

【0055】

このとき、半導体ウェハーWの表面温度が0.1ミリセカンドないし10ミリセカンド程度の極めて短い時間で処理温度T2まで昇温されることから、半導体ウェハーW中のイオン活性化は短時間で完了する。従って、半導体ウェハーWに打ち込まれたイオンが拡散することはなく、半導体ウェハーWに打ち込まれたイ

オンのプロファイルがなまるという現象の発生を防止することが可能となる。なお、イオン活性化に必要な時間はイオンの拡散に必要な時間に比較して極めて短いため、0.1ミリ秒ないし10ミリ秒程度の拡散が生じない短時間であってもイオン活性化は完了する。

【0056】

また、フラッシュランプ69を点灯して半導体ウェハ－Wを加熱する前に、加熱プレート74を使用して半導体ウェハ－Wの表面温度を200℃ないし600℃程度の予備加熱温度T1まで加熱していることから、フラッシュランプ69により半導体ウェハ－Wを1000℃ないし1100℃程度の処理温度T2まで速やかに昇温させることが可能となる。

【0057】

フラッシュ加熱工程が終了した後に、熱拡散板73および加熱プレート74がモータ40の駆動により図1に示す半導体ウェハ－Wの搬入・搬出位置まで下降するとともに、ゲートバルブ68により閉鎖されていた開口部66が解放される。そして、支持ピン70上に載置された半導体ウェハ－Wが図示しない搬送ロボットにより搬出される。以上のようにして、一連の熱処理動作が完了する。

【0058】

以上のような一連の熱処理工程において、本実施形態ではフラッシュランプ69から出射される光の強度を監視している。以下その光強度監視動作について説明する。

【0059】

上述したフラッシュ加熱時にフラッシュランプ69から閃光が出射されると、その光の一部が光ファイバー20によって受光される。このときに、各フラッシュランプ69の中央部および両端部のそれぞれに光ファイバー20の端面が対向しているため、各フラッシュランプ69の中央部および両端部それぞれの箇所から出射された光が個別に受光されることとなる。受光された光は光ファイバー20によって導かれて出射され、フィルター23を通過してCCD25により受光される。

【0060】

図 7 は、フラッシュランプ 6 9 から閃光が出射されたときのフィルター 2 3 の出射面のイメージを示す図である。同図は、各フラッシュランプ 6 9 の中央部に対向配置された光ファイバー 2 0 によって導かれた光がフィルター 2 3 を通過するときのイメージを示している。図 7 中の 1 つの円はあるフラッシュランプ 6 9 から出射されて光ファイバー 2 0 によって導かれた光がフィルター 2 3 を通過するときのイメージである。このように、各フラッシュランプ 6 9 の中央部から出射された光が個別にフィルター 2 3 を通過する。そして、CCD 2 5 は図 7 のライン C 1 上の光量を計測して電気信号に変換し、その電気信号がコンピュータ 1 0 に伝達される。

【 0 0 6 1 】

図 8 および図 9 は、CCD 2 5 から出力された電気信号の波形の例を示す図である。図 8 および図 9 において、横軸は CCD 2 5 のセル位置を示し、縦軸は CCD 2 5 から出力された電気信号の強度を示している。また、図中 P 1 ~ P 6 は、各光ファイバー 2 0 から出射された光（正確には当該光ファイバー 2 0 が対向するフラッシュランプ 6 9 の所定部位から出射された光）の中心に位置するセル位置、具体的には図 7 の円形のイメージの中心に位置するセル位置を示している。ここで、セル位置 P 1 はフラッシュランプ 6 9 a の中心部から出射された光の中心に位置するセル位置である。同様に、セル位置 P 2 はフラッシュランプ 6 9 b の中心部、セル位置 P 3 はフラッシュランプ 6 9 c の中心部、セル位置 P 4 はフラッシュランプ 6 9 d の中心部、セル位置 P 5 はフラッシュランプ 6 9 e の中心部、セル位置 P 6 はフラッシュランプ 6 9 f の中心部から出射された光の中心に位置するセル位置である。すなわち、単一の CCD 2 5 によって複数のフラッシュランプ 6 9 のそれぞれから出射される光の強度を計測するのである。なお、フラッシュランプ 6 9 a ~ フラッシュランプ 6 9 f は光源 5 に設けられた 2 7 本のフラッシュランプ 6 9 のうちの 1 本である（以降、特に区別を必要としないときは単にフラッシュランプ 6 9 とする）。

【 0 0 6 2 】

図 8 に示す波形 F n は、チャンバー 6 5 内にて熱拡散板 7 3 および加熱プレート 7 4 によって熱処理位置に保持された半導体ウェハー W への照射状態が所定の

基準を満足するときの複数のフラッシュランプ69のそれぞれから出射される光の強度を示している。「照射状態が所定の基準を満足するとき」とは、例えば半導体ウェハ－W上の照度のバラツキが所定の範囲内に収まっているときである。このような状態は、熱処理装置の設置時やメンテナンス時等に各フラッシュランプ69の調整等が行われることにより実現される。そして、メンテナンス完了時等に上述した「照射状態が所定の基準を満足するとき」の複数のフラッシュランプ69のそれぞれから出射される光の強度が予め測定され、コンピュータ10は、その光強度を示す波形F_nを磁気ディスク14に格納しておく。

【0063】

なお、半導体ウェハ－Wへの照射状態が所定の基準を満足するときに、各フラッシュランプ69から出射される光の強度自体は必ずしも均一にならなくて良い。すなわち、図8の波形F_nに示すように、フラッシュランプ69a～フラッシュランプ69fから出射される光の強度がばらついていても、結果として半導体ウェハ－W上の照度のバラツキが所定の範囲内に収まっていれば良く、そのときのフラッシュランプ69から出射される光の強度を示す波形F_nが標準発光強度としてコンピュータ10に予め記憶されるのである。

【0064】

一方、図9に示す波形G_nは、実際に処理対象となるある半導体ウェハ－Wへのフラッシュ加熱を行うときの複数のフラッシュランプ69のそれぞれから出射される光の強度を示している。フラッシュ加熱を行うときには必ずフラッシュランプ69が発光し、その都度フラッシュランプ69から出射された光がCCD25によって受光され、波形G_nが得られるのである。すなわち、処理対象となる半導体ウェハ－Wに光照射を行うごとに、27本のフラッシュランプ69のそれぞれから出射される光の強度を示す波形G_nが取得されるのである。

【0065】

そして、コンピュータ10のCPU11は、波形G_nが得られるごとに標準発光強度である波形F_nと波形G_nとを比較して27本のフラッシュランプ69のそれぞれの発光状態を検出するのである。具体的には、CPU11がG_n/F_nの演算を実行する。このことは、標準発光強度である波形F_nによる正規化を行

うことを意味している。

【 0 0 6 6 】

図 1 0 は、図 9 に示す波形 G_n に対する図 8 に示す標準発光強度である波形 F_n の強度比を示す図である。同図に示すように、セル位置 P_1 およびセル位置 P_5 における波形 G_n の強度が標準発光強度である波形 F_n よりも低下している。このことはフラッシュランプ 6 9 a, 6 9 e から出射される光の強度が波形 F_n を取得したときよりも低下していること、つまりフラッシュランプ 6 9 a, 6 9 e の劣化を意味している。特に、セル位置 P_1 における強度比が大きく低下しており、フラッシュランプ 6 9 a の劣化の程度が大きいことが明らかである。

【 0 0 6 7 】

本実施形態では、CPU 1 1 が光源 5 に設けられた 2 7 本のフラッシュランプ 6 9 のうちの少なくとも 1 本についての図 1 0 に示す強度比が 0. 9 8 以下となったか否かを判断し、0. 9 8 以下となった時点で当該フラッシュランプ 6 9 が劣化している旨の警告を発する。警告としては、例えば CPU 1 1 が表示部 1 6 に警告メッセージを表示するようにすれば良い。

【 0 0 6 8 】

また、CPU 1 1 が光源 5 に設けられた 2 7 本のフラッシュランプ 6 9 のうちの少なくとも 1 本についての図 1 0 に示す強度比が 0. 9 5 以下となったか否かを判断し、0. 9 5 以下となった時点で熱処理装置を停止する。上記の例では、フラッシュランプ 6 9 a についての強度比が 0. 9 5 以下となっているため、CPU 1 1 はフラッシュランプ 6 9 a の劣化の程度が激しいと判断して熱処理装置を停止する。また、仮にフラッシュランプ 6 9 a についての強度比が正常であったとしても、フラッシュランプ 6 9 e についての強度比が 0. 9 8 以下となっているときには、CPU 1 1 はフラッシュランプ 6 9 e の劣化が進行していると判断して表示部 1 6 に警告メッセージを表示する。

【 0 0 6 9 】

なお、図 1 0 に示す強度比がどの程度まで低下した時点で異常対応処理を行うかは、予め実験等によって強度比がどの程度まで低下した時点で半導体ウェハ W 上の照度分布の均一性が損なわれるかを調査した上で設定しておけば良い。

【 0 0 7 0 】

熱処理装置が停止したときにはフラッシュランプ 6 9 の交換等を行う。好ましくは、警告が発せられた段階でフラッシュランプ 6 9 の交換等を行う。そして、このようなメンテナンスを行い、半導体ウェハ W 上の照度のバラツキが所定の範囲内に収まった時点で、複数のフラッシュランプ 6 9 のそれぞれから出射される光の強度を CCD 2 5 によって測定し、その波形 F n を新たな標準発光強度としてコンピュータ 1 0 に記憶させる。

【 0 0 7 1 】

以上のように、本実施形態では、光源 5 から熱拡散板 7 3 および加熱プレート 7 4 に保持された半導体ウェハ W に向けて閃光を出射するときに、光ファイバ 2 0 によって出射光の一部を導き、2 7 本のフラッシュランプ 6 9 のそれぞれから出射される光の強度を CCD 2 5 によって計測している。そして、その計測結果に基づいてコンピュータ 1 0 の CPU 1 1 が 2 7 本のフラッシュランプ 6 9 のそれぞれの発光状態を検出することによって、フラッシュランプ 6 9 から出射される光の強度を監視している。従来の如き定期的なサンプリングや電流特性のモニタリングといった間接的なランプ管理ではなく、フラッシュランプ 6 9 から出射される光を直接受光してその強度を測定することによって各フラッシュランプ 6 9 の発光状態を検出しているため、直接的なランプ管理が可能となり、フラッシュランプ 6 9 の劣化を確実に検出することができる。

【 0 0 7 2 】

また、フラッシュランプ 6 9 の発光状態の検出に際しては、熱拡散板 7 3 および加熱プレート 7 4 に保持された半導体ウェハ W への照射状態が所定の基準を満足するときの 2 7 本のフラッシュランプ 6 9 のそれぞれから出射される光の強度を予め測定して標準発光強度とし、実際に処理対象となる半導体ウェハ W へのフラッシュ加熱を行うときの 2 7 本のフラッシュランプ 6 9 のそれぞれから出射される光の強度と該標準発光強度とを比較している。換言すれば、2 7 本のフラッシュランプ 6 9 相互間の光強度のバラツキの如何に関わらず、実際にフラッシュ加熱を行うときの 2 7 本のフラッシュランプ 6 9 のそれぞれから出射される光の強度を標準発光強度によって正規化することによりフラッシュランプ 6 9 の

発光状態の検出しているため、簡便な手法にてフラッシュランプ 6 9 の劣化を確実に検出することができる。

【 0 0 7 3 】

また、本実施形態ではフラッシュランプ 6 9 の中央部のみならず両端部にも光ファイバー 2 0 を対向させ、当該両端部の発光状態の検出も行っている。フラッシュランプ 6 9 の両端部には電極が配置されているため、電極のスパッタに起因したガラス管の黒化による光量低下が生じやすい。従って、フラッシュランプ 6 9 の両端部を含む複数箇所から出射される光の強度を同時に監視することによってより確実にフラッシュランプ 6 9 の劣化を検出することができる。

【 0 0 7 4 】

また、処理対象となる半導体ウェハ W に光照射を行うごとに、2 7 本のフラッシュランプ 6 9 のそれぞれの発光状態を検出しているため、発光異常が検出されたときに処理された半導体ウェハ W のみが処理不良となる可能性があるだけで済み、従来のサンプリングによる検査のように検査間に処理された全ての半導体ウェハ W に処理不良が生じるおそれはない。

【 0 0 7 5 】

さらに、2 7 本のフラッシュランプ 6 9 から出射される光の強度を単一の CCD 2 5 によって計測しているため、計測回路のバラツキを最小限に抑制することができる。

【 0 0 7 6 】

以上、本発明の実施の形態について説明したが、この発明は上記の例に限定されるものではない。例えば、上記実施形態においては光源 5 に 2 7 本のフラッシュランプ 6 9 を備えるようにしていたが、これに限定されずフラッシュランプ 6 9 の本数は任意のものとすることができる。

【 0 0 7 7 】

また、各フラッシュランプ 6 9 における光強度測定箇所も 3 箇所に限定されるものではなく、少なくとも 1 箇所あれば良い。測定箇所が 1 箇所のときはフラッシュランプ 6 9 の中央部を選択するのが好ましい。測定箇所が複数のときは、中央部と両端部を含むように選択するのが好ましい。

【 0 0 7 8 】

また、光源 5 にフラッシュランプ 6 9 に代えて他の種類のランプ（例えばハロゲンランプ）を備え、当該ランプからの光照射によって半導体ウェハ W の加熱を行う熱処理装置であっても本発明に係る技術を適用することができる。すなわち、複数のランプのそれぞれにおける複数箇所から出射される光の強度を計測し、その計測結果に基づいて当該複数のランプのそれぞれの発光状態を検出するようにしても良い。その具体的な手法は上記実施形態と同じであり、ランプの劣化を確実に検出することができる。

【 0 0 7 9 】

また、上記実施形態においては、半導体ウェハに光を照射してイオン活性化処理を行うようにしていたが、本発明にかかる熱処理装置による処理対象となる基板は半導体ウェハに限定されるものではない。例えば、窒化シリコン膜や多結晶シリコン膜等の種々のシリコン膜が形成されたガラス基板に対して本発明にかかる熱処理装置による処理を行っても良い。一例として、CVD 法によりガラス基板上に形成した多結晶シリコン膜にシリコンをイオン注入して非晶質化した非晶質シリコン膜を形成し、さらにその上に反射防止膜となる酸化シリコン膜を形成する。この状態で、本発明にかかる熱処理装置により非晶質のシリコン膜の全面に光照射を行い、非晶質のシリコン膜が多結晶化した多結晶シリコン膜を形成することもできる。

【 0 0 8 0 】

また、ガラス基板上に下地酸化シリコン膜、アモルファスシリコンを結晶化したポリシリコン膜を形成し、そのポリシリコン膜にリンやボロン等の不純物をドーピングした構造の TFT 基板に対して本発明にかかる熱処理装置により光照射を行い、ドーピング工程で打ち込まれた不純物の活性化を行うこともできる。

【 0 0 8 1 】

一般にこのようなガラス基板は半導体ウェハに比較してサイズが大きく、熱処理時にはガラス基板を少しずつシフトさせつつ 1 本のフラッシュランプを繰り返し発光させることによってフラッシュ加熱を行う。このような場合も、その 1 本のフラッシュランプの発光状態を上記実施形態と同様にして検出することによ

りランプの劣化を確実にかつ簡便に検出することができる。

【0082】

【発明の効果】

以上説明したように、請求項1の発明によれば、光源から保持手段に保持された基板に向けて光を出射するときに、フラッシュランプから出射される光の強度を計測し、その計測結果に基づいてフラッシュランプの発光状態を検出するため、フラッシュランプから出射される光を直接モニタすることとなり、ランプの劣化を確実にかつ簡便に検出することができる。

【0083】

また、請求項2の発明によれば、保持手段に保持された基板への照射状態が所定の基準を満足するときのフラッシュランプから出射される光の強度を標準発光強度とし、光強度計測手段による計測結果と標準発光強度とを比較してフラッシュランプの発光状態を検出するため、より簡便にランプの劣化を確実に検出することができる。

【0084】

また、請求項3の発明によれば、フラッシュランプが長尺の円筒形状を有する棒状ランプであり、光強度計測手段がフラッシュランプの両端部を含む複数箇所から出射される光の強度を計測するため、黒化による光量低下が生じやすい両端部から出射される光をモニタすることができ、より確実にランプの劣化を検出することができる。

【0085】

また、請求項4の発明によれば、光源が複数のフラッシュランプを有し、複数のフラッシュランプのそれぞれから出射される光の強度を計測し、その計測結果に基づいて複数のフラッシュランプのそれぞれの発光状態を検出するため、複数のランプのそれぞれの劣化を確実にかつ簡便に検出することができる。

【0086】

また、請求項5の発明によれば、複数のフラッシュランプのそれぞれの発光状態のうち少なくとも一部に所定の基準を満足しないものが生じたときに所定の異常対応処理を行うため、ランプの劣化の程度に応じた適切な処理を行うことがで

きる。

【0087】

また、請求項6の発明によれば、処理対象となる基板に光照射を行うごとに複数のフラッシュランプのそれぞれの発光状態を検出するため、ランプの劣化の程度を絶えず監視することができる。

【0088】

また、請求項7の発明によれば、光強度計測手段が複数のフラッシュランプのそれぞれから出射される光を導く複数の光ファイバーと、複数の光ファイバーによって導かれた光を受光する単一の受光素子とを含むため、複数のフラッシュランプから出射された光を単一の受光素子にて受光することができ、計測回路のバラツキを最小限に抑制することができる。

【0089】

また、請求項8の発明によれば、複数のランプのそれぞれにおける複数箇所から出射される光の強度を計測し、その計測結果に基づいて複数のランプのそれぞれの発光状態を検出するため、ランプから出射される光を直接モニタすることとなり、ランプの劣化を確実かつ簡便に検出することができる。

【0090】

また、請求項9の発明によれば、保持手段に保持された基板への照射状態が所定の基準を満足するときの複数のランプのそれぞれから出射される光の強度を標準発光強度とし、光強度計測手段による計測結果と標準発光強度とを比較して複数のランプのそれぞれの発光状態を検出するため、より簡便にランプの劣化を確実に検出することができる。

【0091】

また、請求項10の発明によれば、複数のランプのそれぞれの発光状態のうち少なくとも一部に所定の基準を満足しないものが生じたときに所定の異常対応処理を行うため、ランプの劣化の程度に応じた適切な処理を行うことができる。

【0092】

また、請求項11の発明によれば、光強度計測手段が複数のランプのそれぞれから出射される光を導く複数の光ファイバーと、複数の光ファイバーによって導

かれた光を受光する単一の受光素子とを含むため、複数のランプから出射された光を単一の受光素子にて受光することができ、計測回路のバラツキを最小限に抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明にかかる熱処理装置の構成を示す側断面図である。

【図 2】

本発明にかかる熱処理装置の構成を示す側断面図である。

【図 3】

光強度計測機構の概略構成を示す図である。

【図 4】

コンピュータの構成を示すブロック図である。

【図 5】

フラッシュランプに対する光ファイバーの配設状態を示す図である。

【図 6】

リフレクタへの光ファイバーの取付態様を示す拡大図である。

【図 7】

フラッシュランプから閃光が出射されたときのフィルターの出射面のイメージを示す図である。

【図 8】

CCDから出力された電気信号の波形の例を示す図である。

【図 9】

CCDから出力された電気信号の波形の例を示す図である。

【図 10】

図 9 に示す波形に対する図 8 に示す標準発光強度である波形の強度比を示す図である。

【符号の説明】

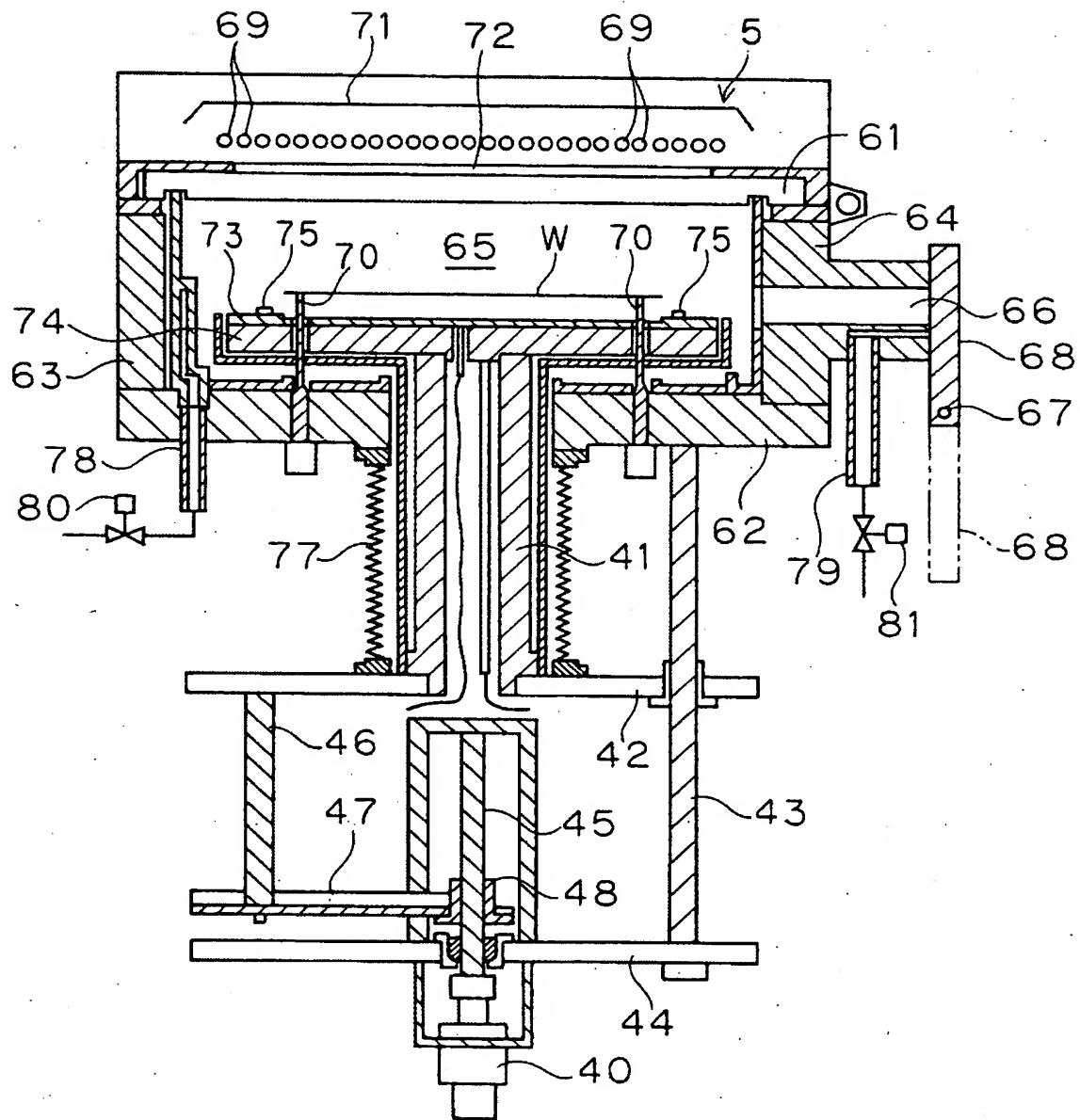
5 光源

10 コンピュータ

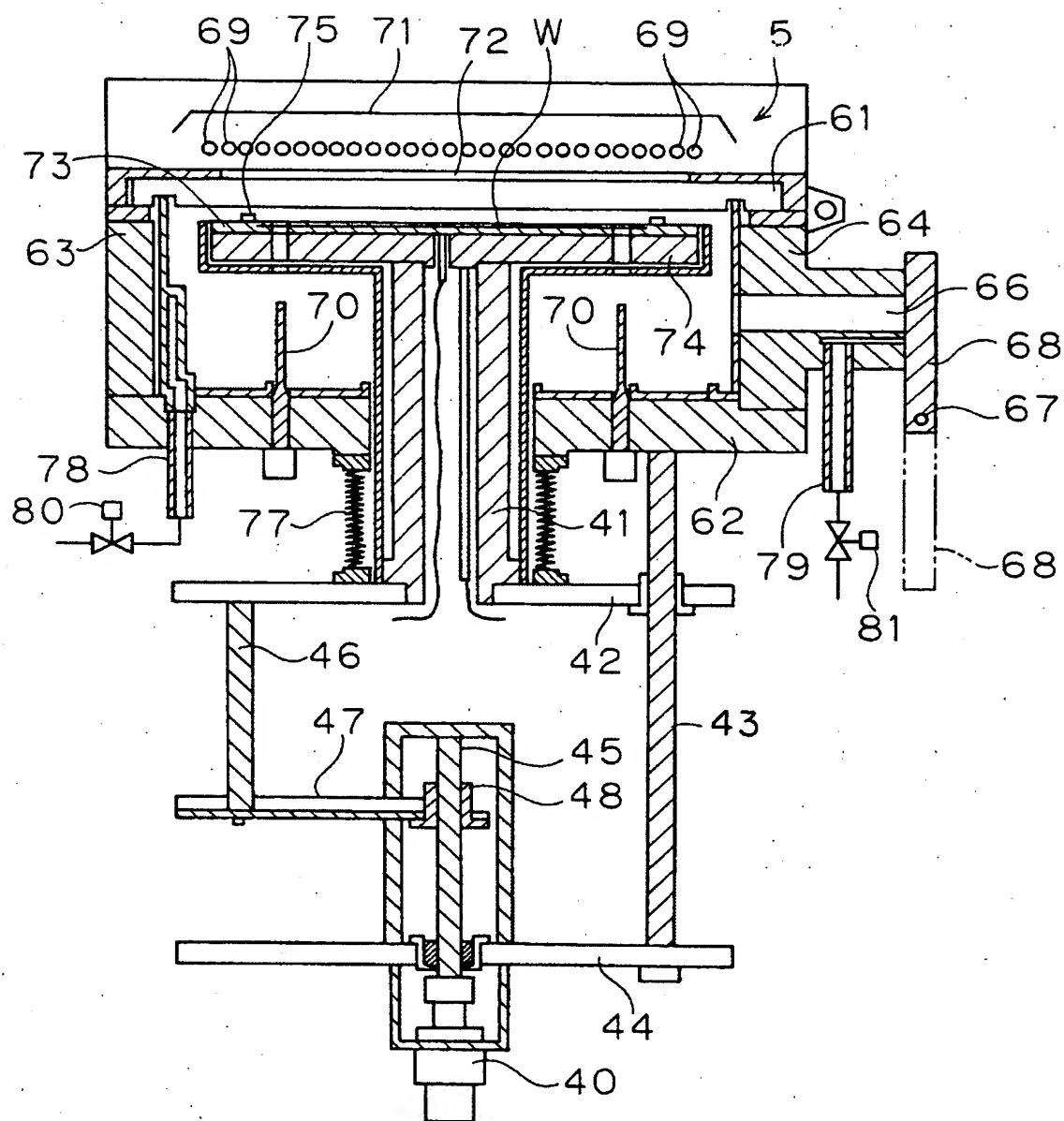
- 11 CPU
- 16 表示部
- 20 光ファイバー
- 23 フィルター
- 25 CCD
- 27 CCD制御回路
- 65 チャンバー
- 69 フラッシュランプ
- 71 リフレクタ
- 73 熱拡散板
- 74 加熱プレート
- W 半導体ウェハー

【書類名】 図面

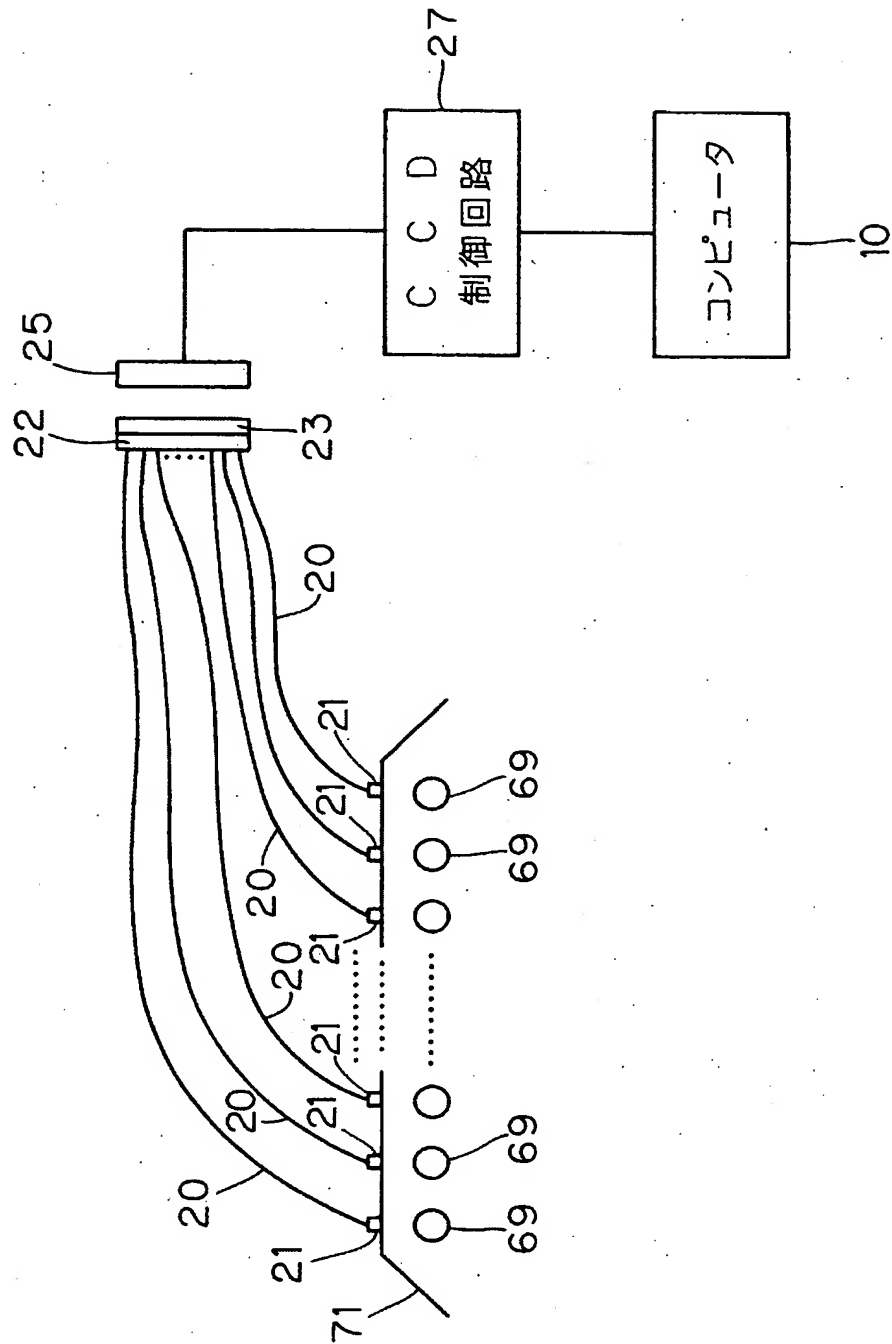
【図1】



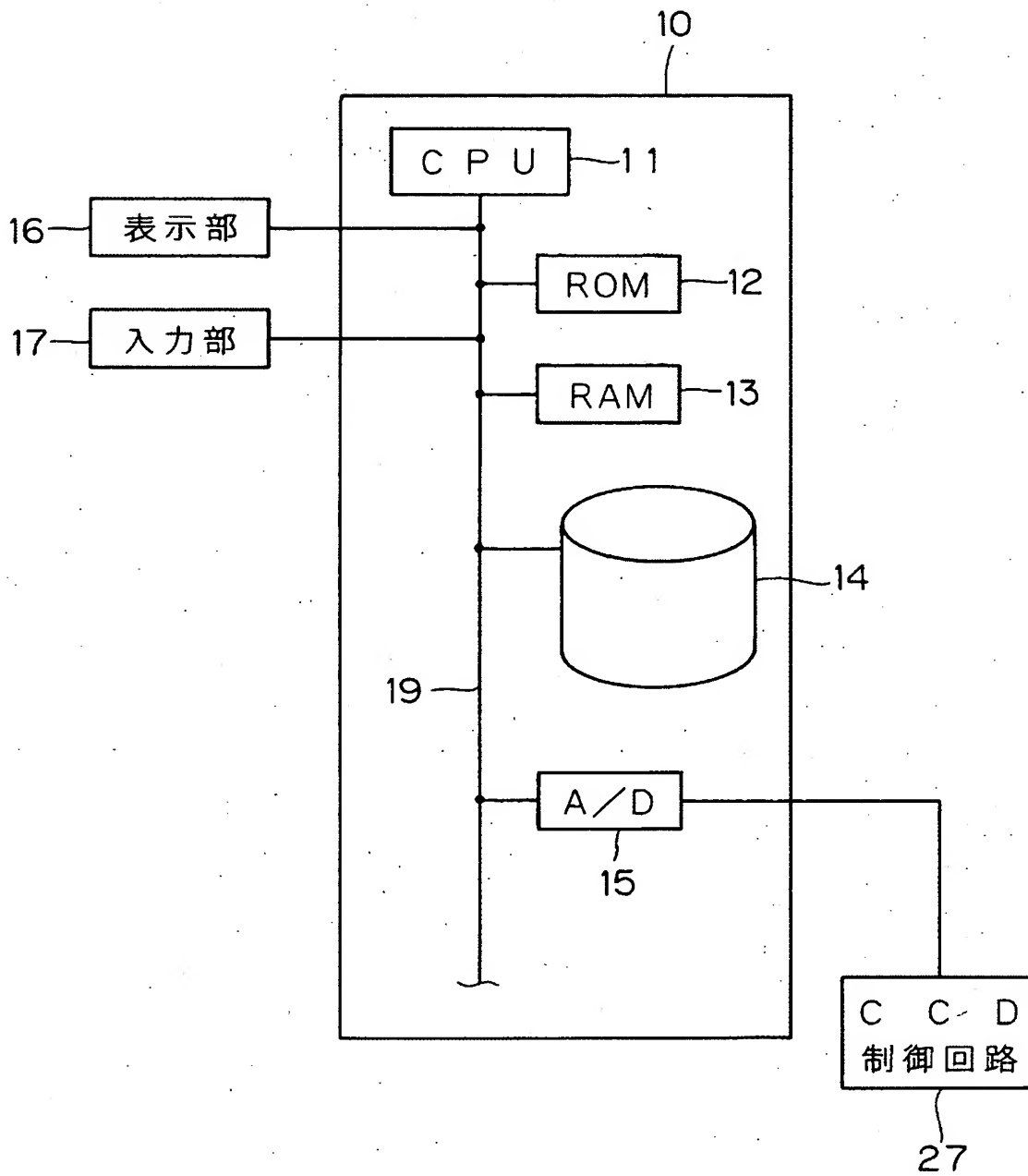
【図2】



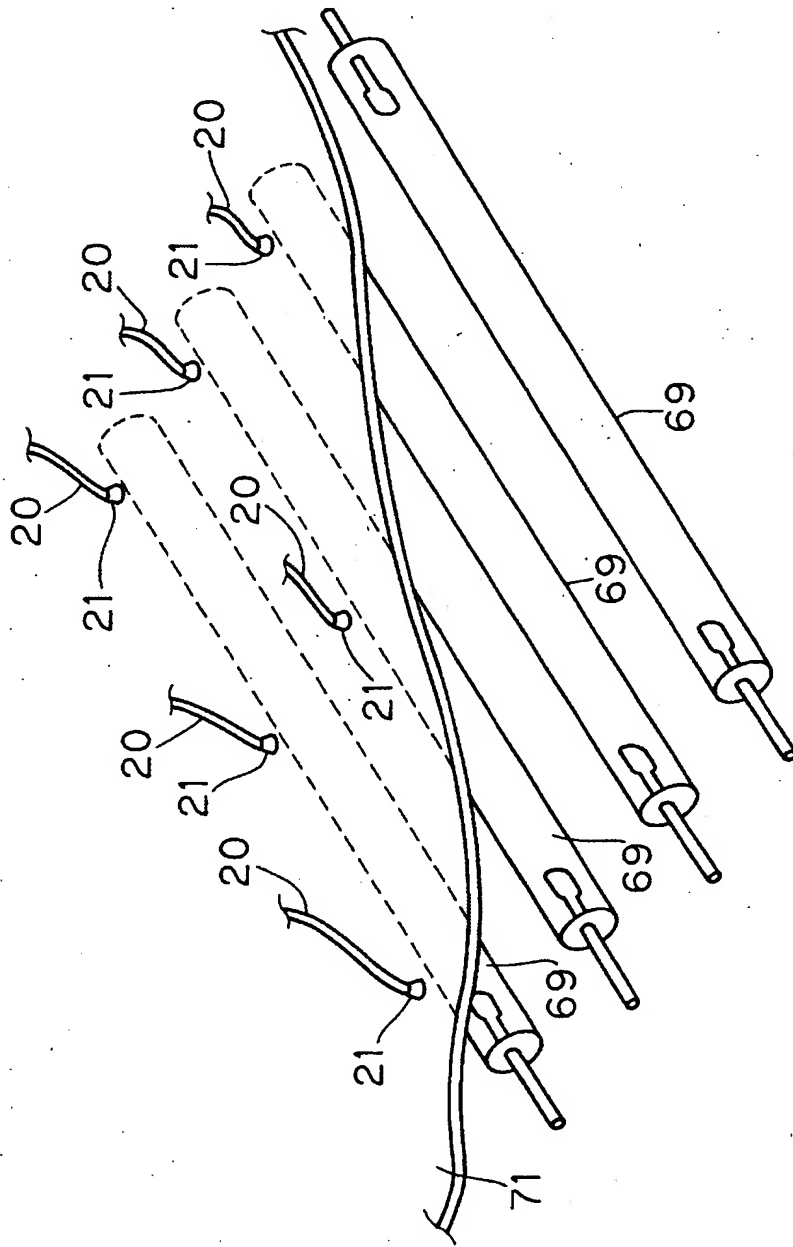
【図 3】



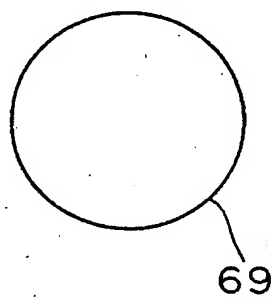
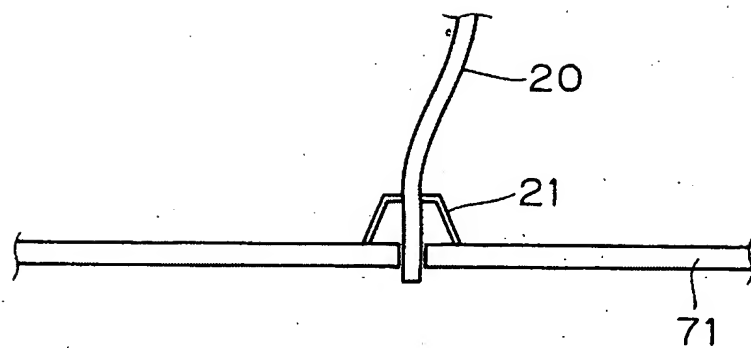
【図4】



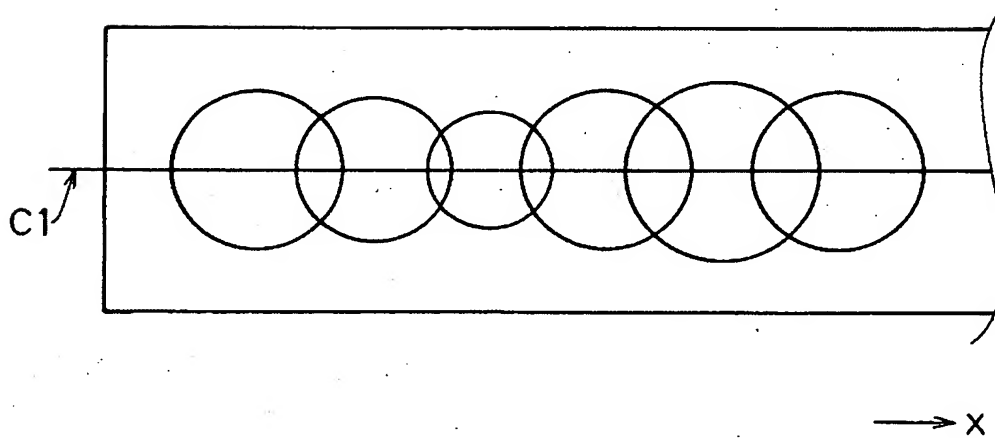
【図5】



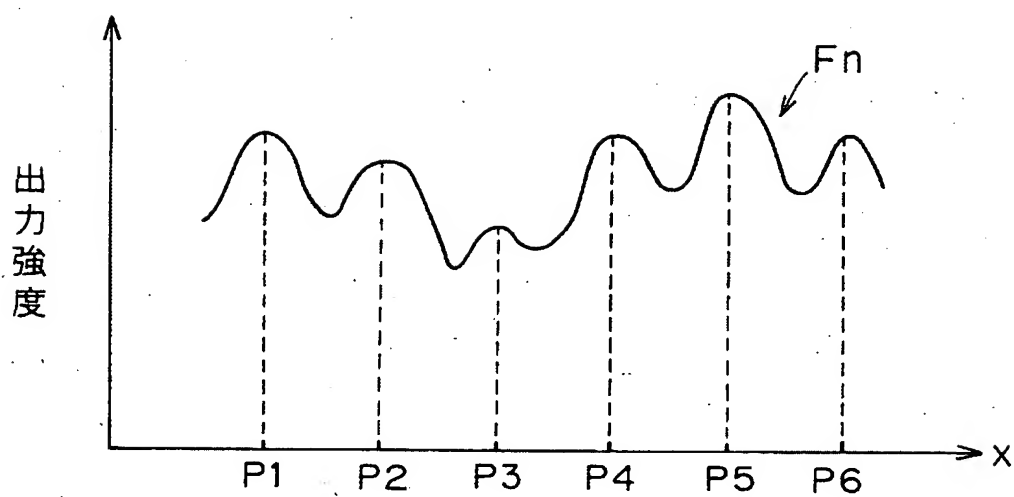
【図6】



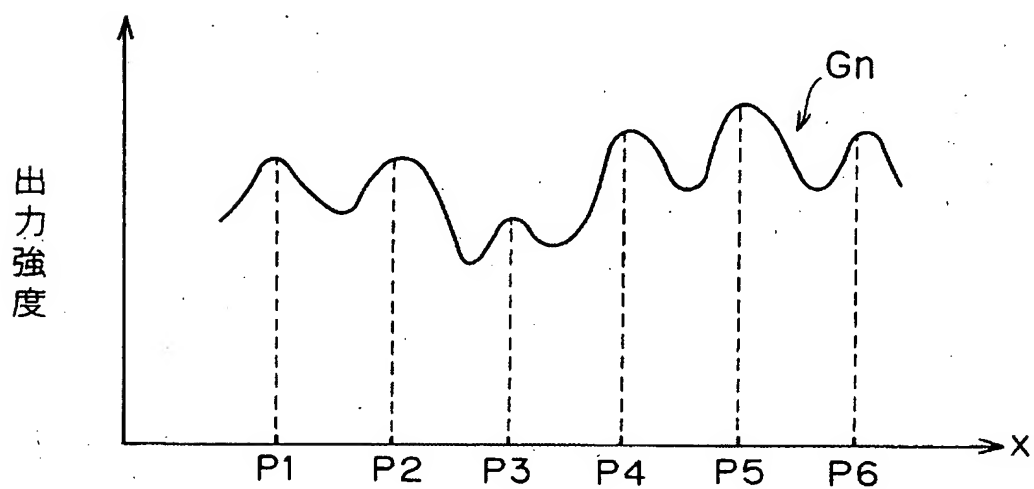
【図7】



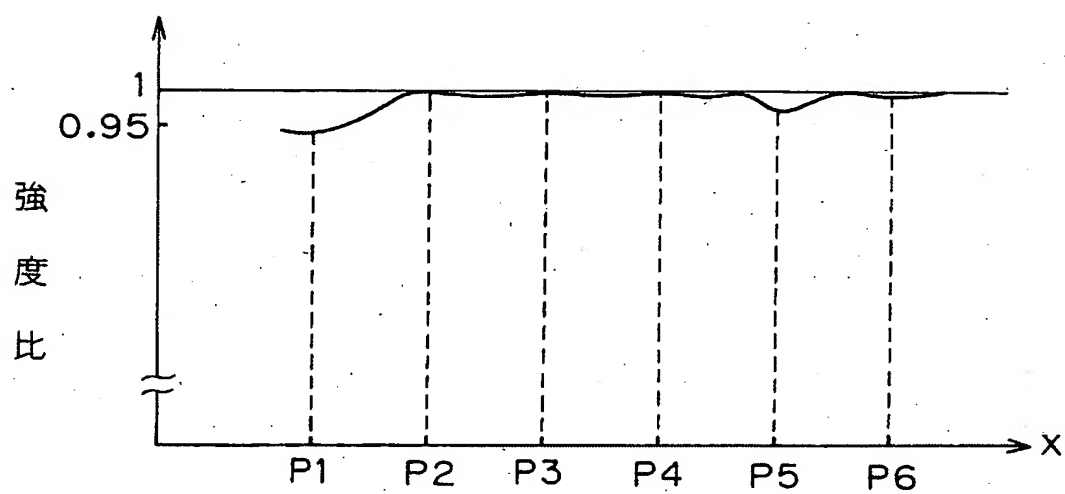
【図 8】



【図 9】



【図10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ランプの劣化を確実に検出することができる熱処理装置を提供する。

【解決手段】 複数のフラッシュランプ 6 9 はリフレクタ 7 1 に覆われている。リフレクタ 7 1 には、各フラッシュランプ 6 9 の直上部分に光ファイバー 2 0 が取り付けられている。フラッシュランプ 6 9 から半導体ウェハーに向けて閃光を出射するときに、光ファイバー 2 0 によって出射光の一部を導き、複数のフラッシュランプ 6 9 のそれぞれから出射される光の強度を CCD 2 5 によって計測している。そして、その計測結果に基づいてコンピュータ 1 0 が複数のフラッシュランプ 6 9 のそれぞれの発光状態を検出している。このときに、半導体ウェハーへの照射状態が所定の基準を満足するときの標準発光強度と、実際の処理時の発光強度とを比較して複数のフラッシュランプ 6 9 の発光状態を検出している。

【選択図】 図 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000207551]

1. 変更年月日	1990年 8月15日
[変更理由]	新規登録
住 所	京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の 1
氏 名	大日本スクリーン製造株式会社